
	<h2>SI7862ADP-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7862ADP-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 16V 18A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7862ADP-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2240 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7862ADP-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 16V 18A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2240 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	16V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 29A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7340pF @ 8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7862ADP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7862ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7862ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7862ADP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7862DP-T1</b> VISHAY SI7862DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7862DP VB</b> SI7862DP VB</p>	 <p><b>SI7862ADP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 16V 18A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7860DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7860DP-TI-E3</b> VISHAY SI7860DP-TI-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7862DP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SI7862ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 16V 18A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7862ADP SI</b> SI7862ADP SI</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3	 SI7856DP-TI-E3	 SI7858ADP
 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP
 SI7858BDP-T1-E3	 SI7860ADP	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3
 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-TI-E3	 SI7860DP	 SI7860DP-T1	 SI7860DP-T1-E3
 SI7860DP-T1-E3	 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-T1-GE3	 SI7860DP-TI-E3	 SI7862ADP
 SI7862ADP-T1-E3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862ADP-T1-GE3	 SI7862DP	 SI7862DP-T1
 SI7864ADP	 SI7864ADP-T1-GE3	 SI7864DP-T1-GE3	 SI7866ADP	 SI7866ADP-T1-E3
 SI7866ADP-T1-E3	 SI7866ADP-T1-GE3	 SI7866ADP-T1-GE3	 SI7866DP-T1	 SI7866DP-T1-E3
 SI7866DP-T1-GE3	 SI7868ADP	 SI7868ADP-T1-E3	 SI7868ADP-T1-E3	 SI7868ADP-T1-GE3
 SI7868ADP-T1-GE3	 SI7868DP-T1	 SI7868DP-T1-E3	 SI7868DP-T1-GE3	 SI786LG-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited